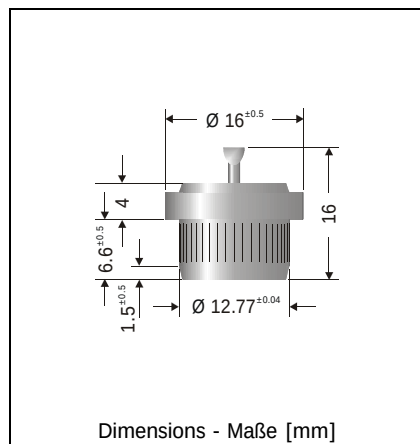


KYZ25A05 ... KYZ25A6, KYZ25K05 ... KYZ25K6
Silicon-Press-Fit-Diodes – High Temperature Diodes
Silizium-Einpress-Dioden – Hochtemperatur-Dioden

Version 2006-04-20


Nominal Current
Nennstrom 25 A

Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung 50 ... 600 V

Metal press-fit case with glass seal
Metall-Einpressgehäuse mit Glas-Durchführung

Weight approx. – Gewicht ca. 10 g

Compound has classification UL94V-0
Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging: bulk
Standard Lieferform: lose im Karton
**Maximum ratings****Grenzwerte**

Type / Typ Wire to / Draht an		Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
Anode	Cathode		
KYZ25A05	KYZ25K05	50	60
KYZ25A1	KYZ25K1	100	120
KYZ25A2	KYZ25K2	200	240
KYZ25A3	KYZ25K3	300	360
KYZ25A4	KYZ25K4	400	480
KYZ25A6	KYZ25K6	600	700

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 150^\circ\text{C}$	I_{FAV}	25 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	90 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	270/300 A
Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	375 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+175°C -50...+175°C

1 Max. case temperature $T_C = 150^\circ\text{C}$ – Max. Gehäusetemperatur $T_C = 150^\circ\text{C}$

Characteristics
Kennwerte

Forward Voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 25\text{ A}$	V_F	$< 1.1\text{ V}$
Leakage Current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 100\text{ }\mu\text{A}$
Thermal Resistance Junction – Case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		R_{thc}	$< 1\text{ K/W}$

